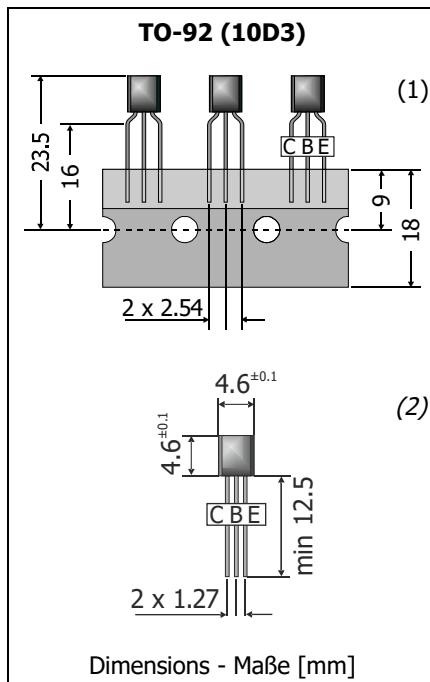


BC337 ... BC338
General Purpose NPN Transistors
Universal-NPN-Transistoren

$I_C = 800 \text{ mA}$ $V_{CE0} = 25...45 \text{ V}$
 $h_{FE} = 160/250/400$ $P_{tot} = 625 \text{ mW}$
 $T_{jmax} = 150^\circ\text{C}$

Version 2017-02-09

**Typical Applications**

Signal processing,
 Switching, Amplification
 Commercial grade ¹⁾

Features

General Purpose
 Three current gain groups
 Compliant to RoHS, REACH,
 Conflict Minerals ¹⁾

Mechanical Data ¹⁾

- (1) Taped in ammo pack (Raster 2.54) 4000
 (2) On request: in bulk (Raster 1.27, suffix "BK") 5000

Weight approx. 0.01 g

Case material UL 94V-0

Solder & assembly conditions 260°C/10s
 MSL N/A

Typische Anwendungen

Signalverarbeitung,
 Schalten, Verstärken
 Standardausführung ¹⁾

Besonderheiten

Universell anwendbar
 Drei Stromverstärkungsklassen
 Konform zu RoHS, REACH,
 Konfliktmineralien ¹⁾

Mechanische Daten ¹⁾

- (1) Gegurtet in Ammo-Pack (Raster 2.54)
 (2) Auf Anfrage: Schüttgut (Raster 1.27, Suffix "BK")

Gewicht ca.

Gehäusematerial

Löt- und Einbaubedingungen

Current gain groups Stromverstärkungsgruppen		Recommended complementary PNP transistors Empfohlene komplementäre PNP-Transistoren
BC337-16 BC337-25 BC337-40	BC338-16 BC338-25 BC338-40	BC327 ... BC328

Maximum ratings ²⁾**Grenzwerte ²⁾**

		BC337	BC338
Collector-Emitter-volt. – Kollektor-Emitter-Spannung	E-B short	V_{CES}	50 V
Collector-Emitter-volt. – Kollektor-Emitter-Spannung	B open	V_{CEO}	45 V
Emitter-Base-voltage – Emitter-Basis-Spannung	C open	V_{EBO}	5 V
Power dissipation – Verlustleistung		P_{tot}	625 mW ³⁾
Collector current – Kollektorstrom (dc)		I_C	800 mA
Peak Collector current – Kollektor-Spitzenstrom		I_{CM}	1 A
Base current – Basisstrom		I_B	100 mA
Junction temperature – Sperrschichttemperatur		T_j	-55...+150°C
Storage temperature – Lagerungstemperatur		T_s	-55...+150°C

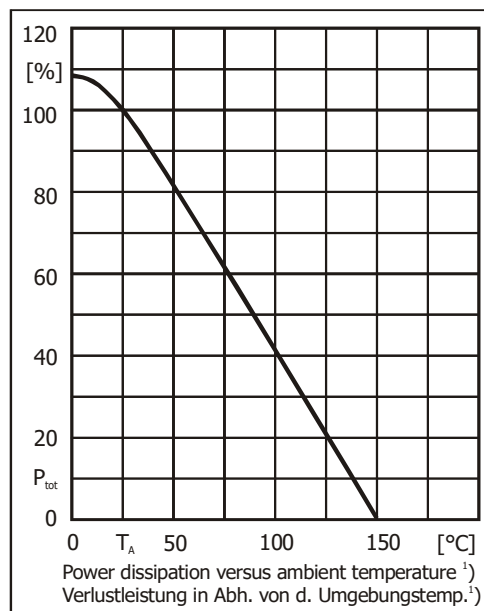
1 Please note the [detailed information on our website](#) or at the beginning of the data book
 Bitte beachten Sie die [detaillierten Hinweise auf unserer Internetseite](#) bzw. am Anfang des Datenbuches

2 $T_A = 25^\circ\text{C}$, unless otherwise specified – $T_A = 25^\circ\text{C}$, wenn nicht anders angegeben

3 Valid, if leads are kept at ambient temperature at a distance of 2 mm from case
 Gültig wenn die Anschlussdrähte in 2 mm Abstand vom Gehäuse auf Umgebungstemperatur gehalten werden

Characteristics
Kennwerte

				$T_j = 25^\circ\text{C}$			
				Min.	Typ.	Max.	
DC current gain – Kollektor-Basis-Stromverhältnis							
$V_{CE} = 1\text{ V}, I_C = 100\text{ mA}$	Group -16	h_{FE}		100	160	250	
	Group -25			160	250	400	
	Group -40			250	400	630	
$V_{CE} = 1\text{ V}, I_C = 300\text{ mA}$	Group -16	h_{FE}		60	130	–	
	Group -25			100	200	–	
	Group -40			170	320	–	
Collector-Emitter saturation voltage – Kollektor-Sättigungsspannung ¹⁾							
$I_C = 500\text{ mA}, I_B = 50\text{ mA}$				V_{CEsat}	–	–	0.7 V
Base-Emitter-voltage – Basis-Emitter-Spannung ¹⁾							
$V_{CE} = 1\text{ V}, I_C = 300\text{ mA},$				V_{BE}	–	–	1.2 V
Collector-Emitter cutoff current – Kollektor-Emitter-Reststrom							
$V_{CE} = 45\text{ V}$ $V_{CE} = 25\text{ V}$	B-E short	BC337 BC338	I_{CES}	–	2 nA	100 nA	
				–	2 nA	100 nA	
$V_{CE} = 45\text{ V}$ $V_{CE} = 25\text{ V}$	$T_j = 125^\circ\text{C}$	B-E short	BC337 BC338	I_{CES}	–	10 μA	
				I_{CES}	–	10 μA	
Gain-Bandwidth Product – Transitfrequenz							
$V_{CE} = 5\text{ V}, I_C = 10\text{ mA}, f = 50\text{ MHz}$				f_T	–	100 MHz	–
Collector-Base Capacitance – Kollektor-Basis-Kapazität							
$V_{CB} = 10\text{ V}, I_E = I_C = 0, f = 1\text{ MHz}$				C_{CBO}	–	12 pF	–
Thermal resistance junction to ambient Wärmewiderstand Sperrschicht – Umgebung				R_{thA}	< 200 K/W ²⁾		



Disclaimer: See data book page 2 or [website](#)
Haftungsausschluss: Siehe Datenbuch Seite 2 oder [Internet](#)

- 1 Tested with pulses $t_p = 300\ \mu\text{s}$, duty cycle $\leq 2\%$
Gemessen mit Impulsen $t_p = 300\ \mu\text{s}$, Schaltverhältnis $\leq 2\%$
- 2 Valid, if leads are kept at ambient temperature at a distance of 2 mm from case
Gültig wenn die Anschlussdrähte in 2 mm Abstand vom Gehäuse auf Umgebungstemperatur gehalten werden

X-ON Electronics

Largest Supplier of Electrical and Electronic Components

Click to view similar products for [Bipolar Transistors - BJT category](#):

Click to view products by [Diodec manufacturer](#):

Other Similar products are found below :

[619691C](#) [MCH4017-TL-H](#) [MJ15024/WS](#) [MJ15025/WS](#) [BC546/116](#) [BC556/FSC](#) [BC557/116](#) [BSW67A](#) [HN7G01FU-A\(T5L,F,T](#)
[NJVMJD148T4G](#) [NSVMMBT6520LT1G](#) [NTE187A](#) [NTE195A](#) [NTE2302](#) [NTE2330](#) [NTE2353](#) [NTE316](#) [IMX9T110](#) [NTE63](#) [NTE65](#)
[C4460](#) [SBC846BLT3G](#) [2SA1419T-TD-H](#) [2SA1721-O\(TE85L,F\)](#) [2SA1727TLP](#) [2SA2126-E](#) [2SB1202T-TL-E](#) [2SB1204S-TL-E](#) [2SC5488A-](#)
[TL-H](#) [2SD2150T100R](#) [SP000011176](#) [FMC5AT148](#) [2N2369ADCSM](#) [2SB1202S-TL-E](#) [2SC2412KT146S](#) [2SC4618TLN](#) [2SC5490A-TL-H](#)
[2SD1816S-TL-E](#) [2SD1816T-TL-E](#) [CMXT2207 TR](#) [CPH6501-TL-E](#) [MCH4021-TL-E](#) [BC557B](#) [TTC012\(Q\)](#) [BULD128DT4](#) [JANTX2N3810](#)
[Jantx2N5416](#) [US6T6TR](#) [KSF350](#) [068071B](#)